

DOUBLE DIODE-PENTODE with variable mutual conductance
for use as R.F., I.F. or A.F. amplifier
DOUBLE DIODE-PENTHODE à pente variable pour utilisation en amplificatrice H.F., M.F. ou B.F.
DOPPELDIODE-PENTODE mit veränderlicher Steilheit zur Verwendung als HF-, ZF- oder NF-Verstärker

Heating : indirect by A.C. or D.C.
series supply

Chauffage: indirect par C.A. ou C.G. $I_f = 100 \text{ mA}$
alimentation-série

Heizung : indirekt durch Wechsel- $V_f = 17 \text{ V}$
oder Gleichstrom
Serienspeisung

Base, culot, Sockel: NOVAL

Overall length: 67 mm

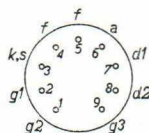
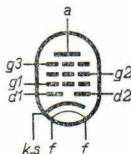
See pages 205 and 253

Hauteur totale: 67 mm

Voir pages 205 et 253

Gesamthöhe : 67 mm

Siehe S. 205 und 253



Capacitances
Capacités
Kapazitäten

Pentode section
Partie penthode
Pentodenteil

Diode section
Partie diode
Diodenteil

$C_a = 4,9 \text{ pF}$

$C_{d1} = 2,2 \text{ pF}$

$C_{g1} = 4,2 \text{ pF}$

$C_{d2} = 2,35 \text{ pF}$

$C_{ag1} < 0,0025 \text{ pF}$

$C_{d1d2} < 0,35 \text{ pF}$

$C_{g1f} < 0,07 \text{ pF}$

$C_{d1f} < 0,02 \text{ pF}$

$C_{d2f} < 0,005 \text{ pF}$

Between pentode and diode sections
Entre les parties penthode et diode
Zwischen Pentoden- und Diodenteilen

$C_{d1g1} < 0,0008 \text{ pF}$

$C_{d2g1} < 0,001 \text{ pF}$

$C_{d1a} < 0,2 \text{ pF}$

$C_{d2a} < 0,05 \text{ pF}$

Operating characteristics as R.F. or I.F. amplifier
Caractéristiques d'utilisation en amplificateur
H.F. ou M.F.

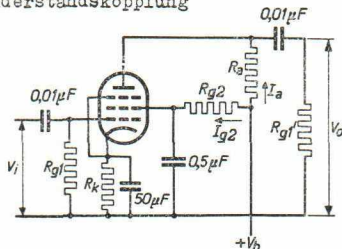
Betriebsdaten als H.F. oder Z.F. Verstärker

$V_a = V_b =$	100	170	200	V
$R_{g2} =$	47	47	68	k Ω
$V_{g3} =$	0	0	0	V
$R_k =$	295	295	295	Ω
$V_{g1} =$	-1,15 -15,5	-2 -26,5	-2 -31,5	V
$I_a =$	2,8 -	5,0 -	5,0 -	mA
$I_{g2} =$	1,0 -	1,75 -	1,75 -	mA
$S =$	1900 19	2200 22	2200 22	$\mu A/V$
$R_i =$	0,9 >10	0,9 >10	1,0 >10	M Ω
$\mu_{g2g1} =$	18 -	18 -	18 -	
$R_{eq} =$	4,6 -	6,2 -	6,2 -	k Ω

Operating characteristics of the pentode section as
resistance coupled A.F. amplifier

Données caractéristiques de la partie penthode en
amplificateur B.F. avec couplage à résistances

Betriebsdaten des Pentodenteiles als N.F. Verstärker
mit Widerstandskopplung



This valve can be used without special precautions
against microphonic effect in circuits in which the
input voltage $V_i \geq 25$ mV for an output of 50 mW of
the output valve.

Ce tube peut être utilisé sans précautions spéciales
contre l'effet microphonique dans des circuits dont
la tension d'entrée $V_i \geq 25$ mV pour une puissance de
50 mW du tube de sortie

Diese Röhre darf ohne spezielle Massnahmen gegen Mi-
krophonie verwendet werden in Schaltungen die für eine
Eingangsspannung $V_i \geq 25$ mV eine Leistung von 50 mW
der Endröhre ergeben.

$V_b = 170 \text{ V}$

R_a (M Ω)	R_{g2} (M Ω)	R_{g1} (M Ω)	R_k (Ω)	$R_{g1'}$ (M Ω)	I_a (mA)	I_{g2} (mA)	V_o V_i	d_{tot} (%)		
								$V_o=$ $3V_{eff}$	$V_o=$ $5V_{eff}$	$V_o=$ $8V_{eff}$
0,22	0,68	1	2700	0,68	0,56	0,20	85	1,2	1,5	1,8
0,1	0,27	1	1000	0,33	1,25	0,50	70	1,2	1,6	2,0
0,22	0,82	10	0	0,68	0,56	0,19	140	0,8	1,0	1,4
0,1	0,33	10	0	0,33	1,16	0,46	100	0,8	1,4	2,0

$V_b = 100 \text{ V}$

R_a (M Ω)	R_{g2} (M Ω)	R_{g1} (M Ω)	R_k (Ω)	$R_{g1'}$ (M Ω)	I_a (mA)	I_{g2} (mA)	V_o V_i	d_{tot} (%)	
								$V_o=$ $3V_{eff}$	$V_o=$ $5V_{eff}$
0,22	0,68	1	2700	0,68	0,32	0,12	82	1,4	1,9
0,1	0,27	1	1000	0,33	0,73	0,29	67	1,4	1,8
0,22	0,82	10	0	0,68	0,32	0,11	100	2,8	3,0
0,1	0,33	10	0	0,33	0,66	0,25	70	1,7	3,2

Operating characteristics as resistance coupled A.F. amplifier in triode connection (g_2 connected to anode).
Données caractéristiques en amplificateur B.F. avec couplage à résistances montée en triode (g_2 relié à l'anode)

Betriebsdaten als N.F. Verstärker mit Widerstandskopplung in Triodenschaltung (g_2 verbunden mit Anode)

V_b (V)	R_a (M Ω)	R_{g1} (M Ω)	R_k (Ω)	$R_{g1'}$ (M Ω)	I_a (mA)	V_o V_i	d_{tot} (%)		
							$V_o=$ $3V_{eff}$	$V_o=$ $5V_{eff}$	$V_o=$ $8V_{eff}$
170	0,1	1	1800	0,33	1,25	11	2,1	3,5	4,8
170	0,047	1	1000	0,15	2,4	11	1,8	3,1	4,6
170	0,1	10	0	0,33	1,4	14	2,5	3,8	5,0
170	0,047	10	0	0,15	2,8	14	2,1	3,4	4,7
100	0,1	1	1800	0,33	0,74	11	3,2	4,9	
100	0,047	1	1000	0,15	1,4	11	3,0	4,8	
100	0,1	10	0	0,33	0,8	12	3,0	4,7	
100	0,047	10	0	0,15	1,5	12	3,0	4,8	

Limiting values of the pentode section
 Caractéristiques limites de la partie penthode
 Grenzdaten des Pentodenteiles

V_{a0}	= max.	550 V
V_a	= max.	250 V
W_a	= max.	1,5 W
V_{g20}	= max.	550 V
$V_{g2} (I_a < 2 \text{ mA})$	= max.	250 V
$V_{g2} (I_a = 5 \text{ mA})$	= max.	125 V
W_{g2}	= max.	0,3 W
I_k	= max.	10 mA
$V_{g1} (I_{g1} = +0,3 \mu\text{A})$	= max.	-1,3 V
$R_{g1} (R_k = 295 \Omega)^1)$	= max.	3 M Ω
R_{kf}	= max.	20 k Ω
V_{kf}	= max.	150 V

Limiting values of the diode section
 Caractéristiques limites de la partie diode
 Grenzdaten des Diodenteiles

$V_{d1 \text{ invp}}$	= max.	350 V
$V_{d2 \text{ invp}}$	= max.	350 V
I_{d1}	= max.	0,8 mA
I_{d2}	= max.	0,8 mA
I_{d1p}	= max.	5 mA
I_{d2p}	= max.	5 mA
R_{kf}	= max.	20 k Ω
V_{kf}	= max.	150 V

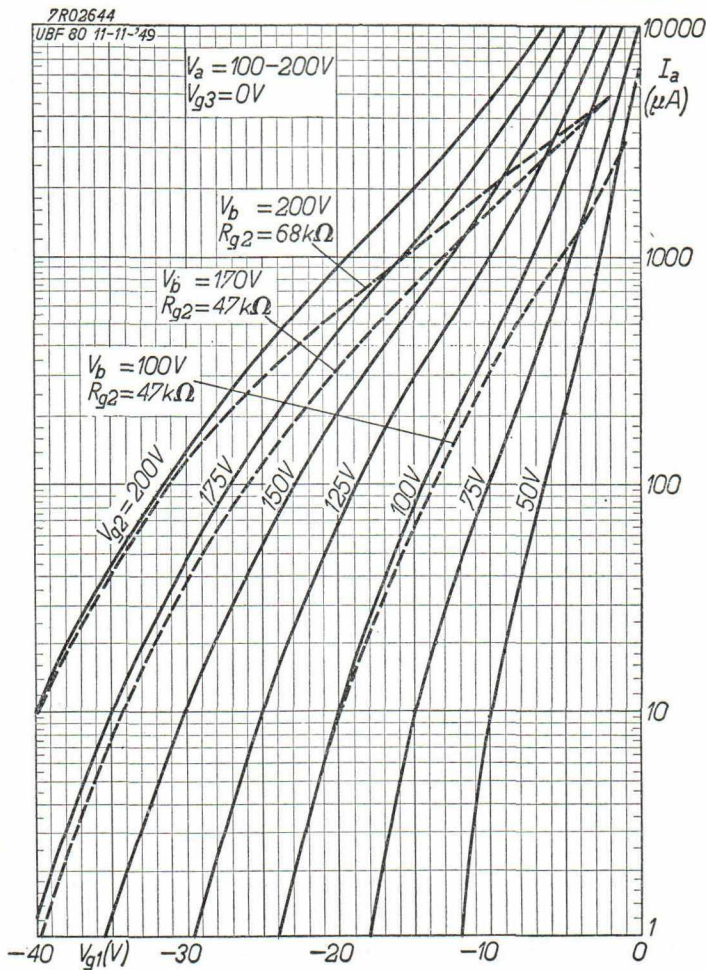
¹⁾ If the grid bias is obtained only by connecting a leakage resistor in the grid circuit, the maximum value of R_{g1} is 22 M Ω .

Si la polarisation négative est obtenue seulement par moyen d'une résistance de fuite dans le circuit de la grille, la valeur maximum de R_{g1} est de 22 M Ω .

Wenn die negative Gittervorspannung nur von einem Ableitungswiderstand in der Gitterleitung erhalten wird, ist der Maximalwert von R_{g1} 22 M Ω .

PHILIPS

UBF 80



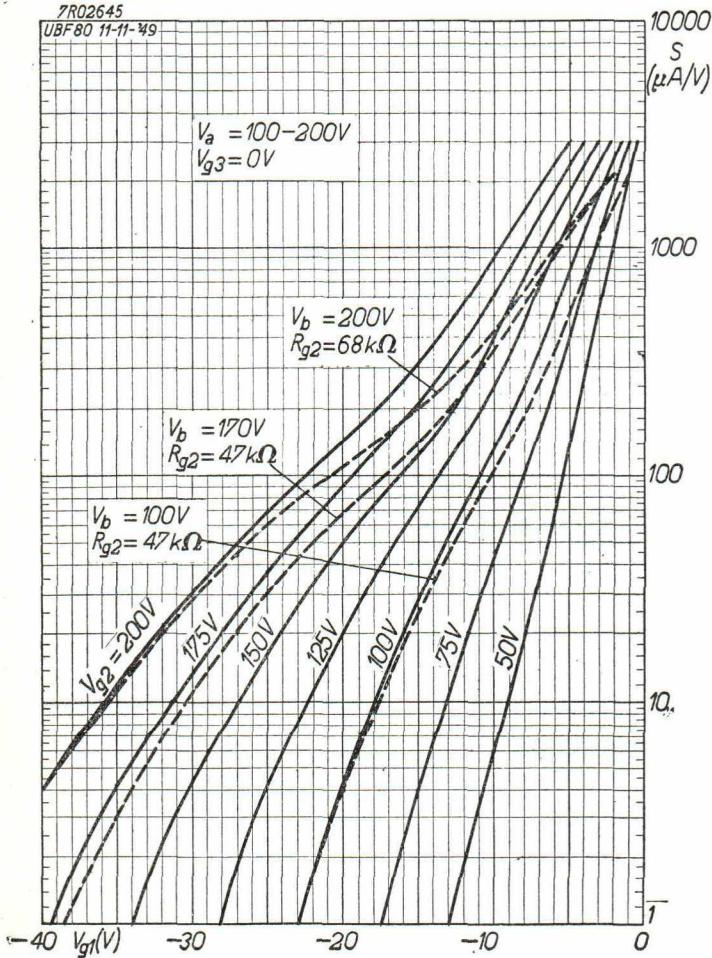
11.11.1949

A

UBF 80**PHILIPS**

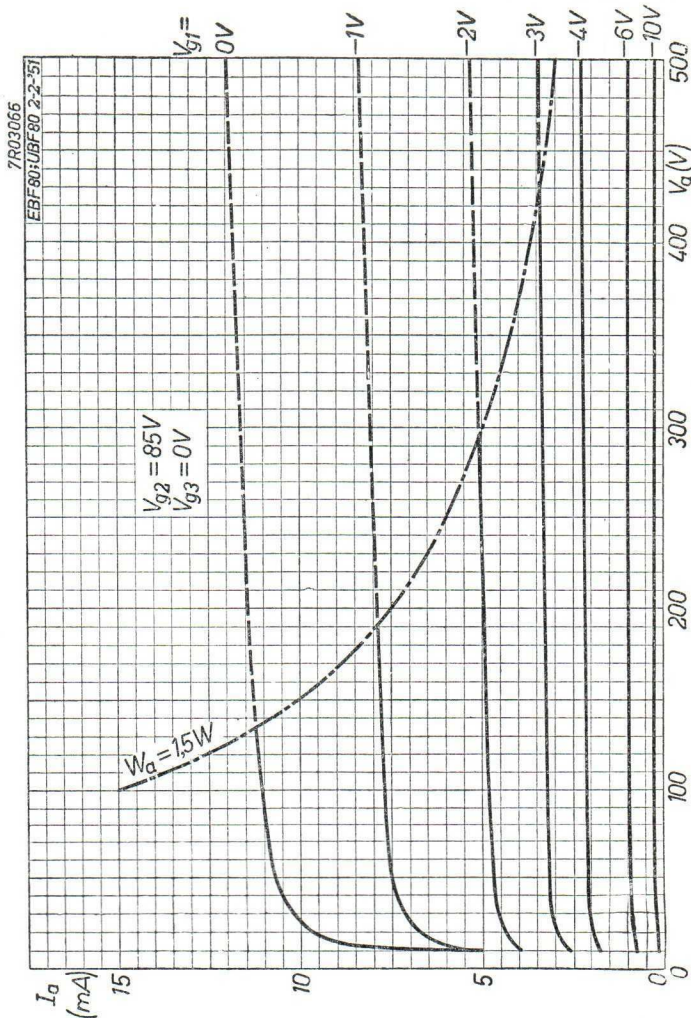
7R02645

UBF80 11-11-49



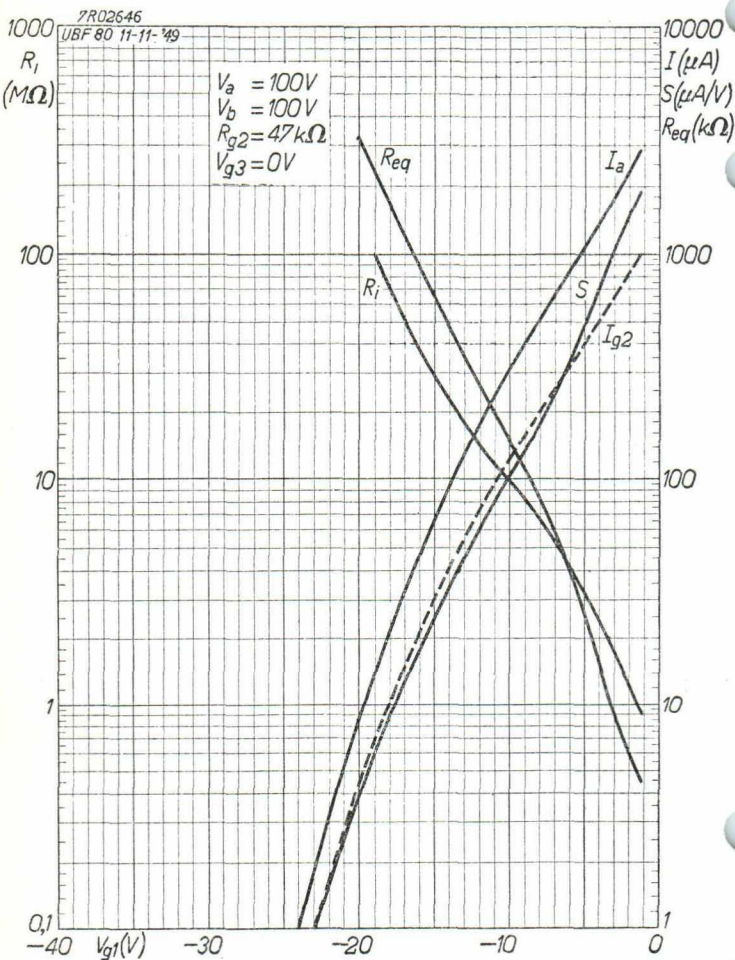
PHILIPS

UBF80



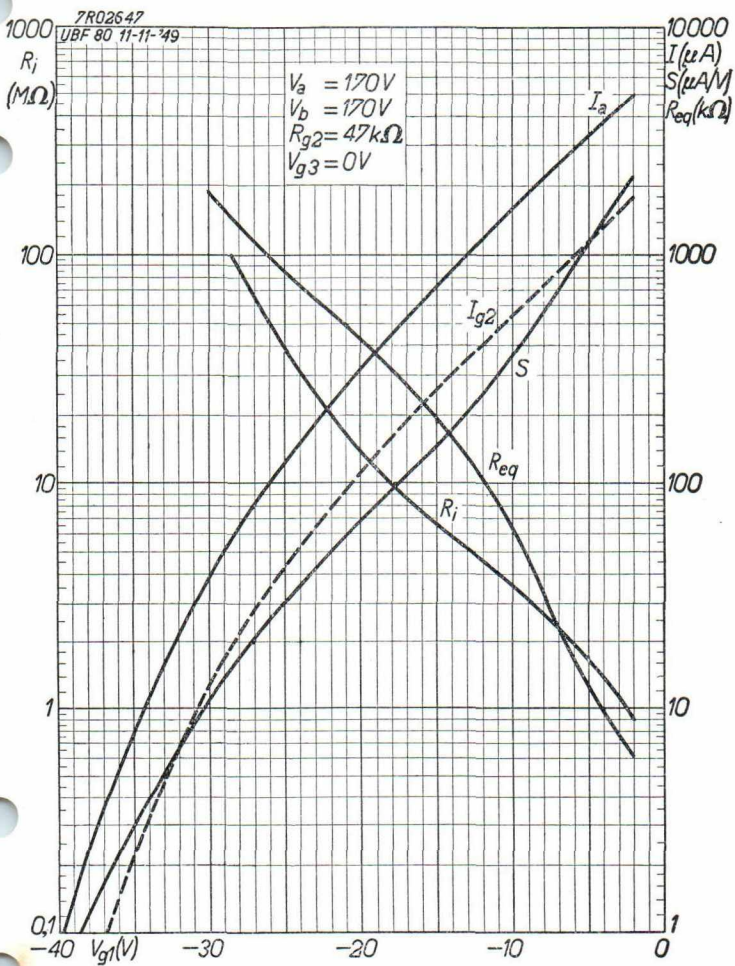
2.2.1951

c

UBF80**PHILIPS**

PHILIPS

UBF 80

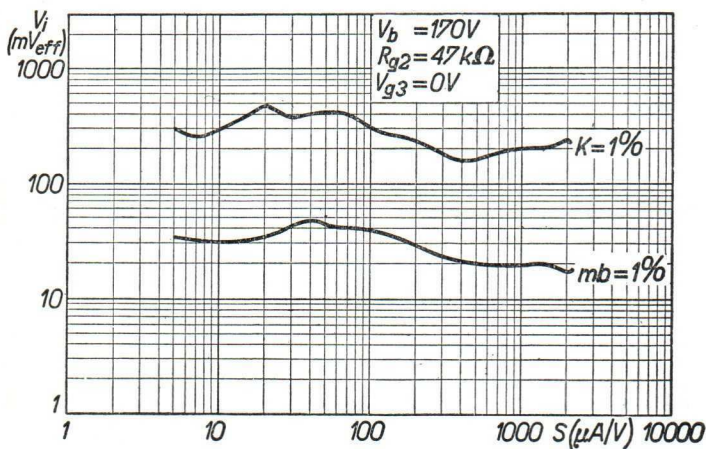
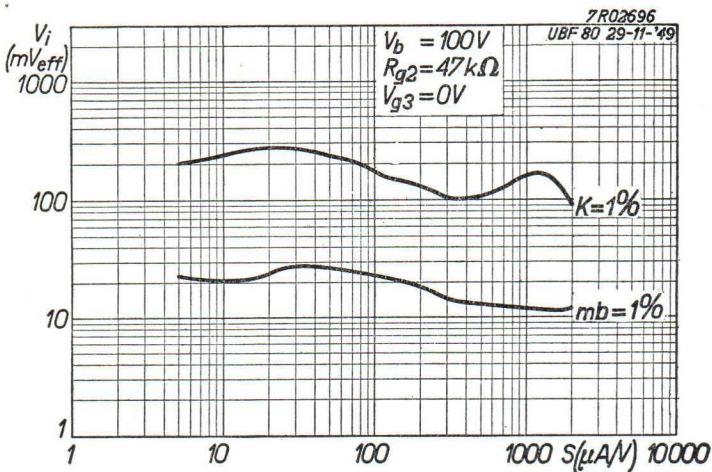


2.2.1951

E

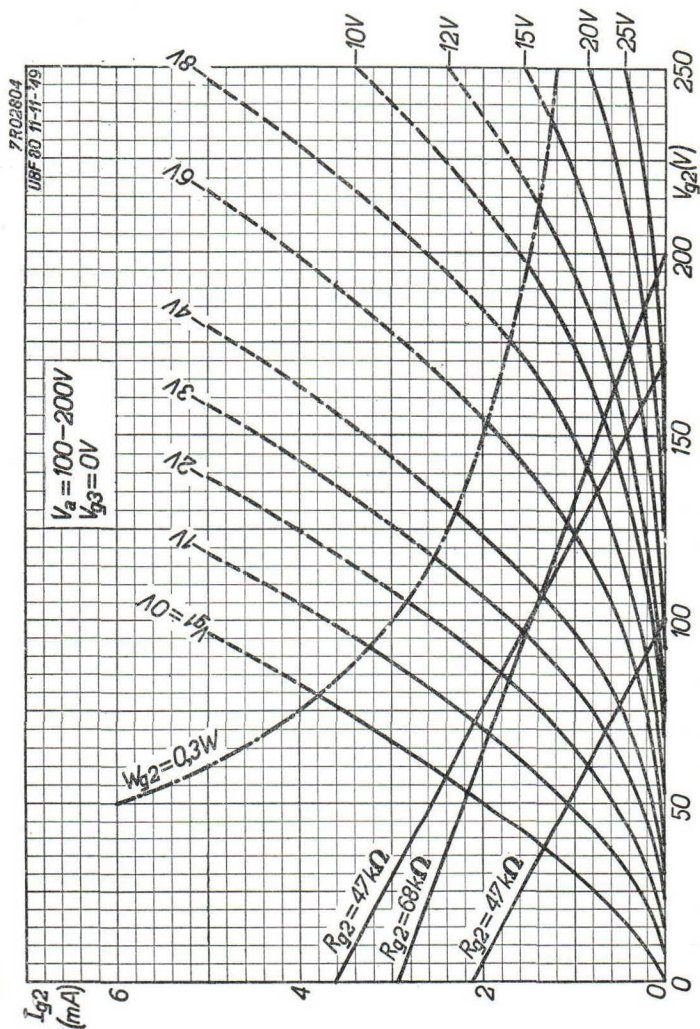
UBF 80

PHILIPS



PHILIPS

UBF 80



2.2.1951

G

